

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

JAPAN PATENT OFFICE (JP)
PATENT APPLICATION PUBLICATION
PATENT PUBLICATION OFFICIAL REPORT (A)
SHO61-141174
Int. Cl. 4 H 01 L 27/14, H 04 N 5/335
IDENTIFICATION NUMBER:
IN-OFFICE SERIAL NUMBER : 7525-5F, 8420-5C
PUBLICATION: June 28, 1986
SUBSTANTIVE EXAMINATION: NOT REQUESTED
THE NUMBER OF INVENTION: 1 (total 4 pages)

1. Title of the Invention: Solid state image pickup device
Patent Application Sho 59-263366
Application December 13, 1984

2. Inventor(s)
Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi
Suwa Seiko-sha
Name: Tetsuyoshi TAKESHITA

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi
Suwa Seiko-sha
Name: Hajime KURIHARA

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi
Suwa Seiko-sha
Name: Hideaki OKA

Address: 3-3-5, Yamato, Suwa-shi
Suwa Seiko-sha
Name: Kazumasa HASEGAWA

3. Applicant
Address: 2-4-1, nishi-shinjyuku, Shinjyuku-ku, Tokyo
Name: SEIKO EPSON CORPORATION

4. Attorney
Patent attorney: Tsutomu MOGAMI

SPECIFICATION

1. Title of the Invention

Solid state image pickup device

2. Scope of Claim for Patent

5 1. A solid state image pickup device of a type of detecting an amount of stored/discharged charges by a light receptive element formed on an insulating substrate, characterized in that a capacitor is provided with an upper electrode in parallel with said light receptive element by oxidizing a portion of a lower electrode of the light receptive element.

10 2. The solid state image pickup device according to claim 1 characterized in that an amorphous silicon is used as the light receptive element, chromium or aluminum is used as the lower electrode and an additional capacitance of an oxide film is formed simultaneously with photoetching the amorphous silicon film.

15 3. Detailed Description of the Invention

"Field of the Invention in Industry"

The present invention relates to a solid state image pickup device utilizing solid state image pickup elements.

"Prior art"

20 Conventionally, CCD type or MOS type is practicable as a solid state image pickup element. In compared with an image pickup tube, the solid state image pickup element is proof against vibration and clash. The solid state image pickup element is characterized in very little power consumption to be used for a long span. Further, MOS type has bigger
25 numerical aperture and has no limit of the amount of transfer charge compared to CCD type, so that a lot of signal can be output. However, MOS type has a defect of occurring a great noise. Fig. 3 shows a drawing of typical MOS type circuit. Referring to the drawing, the cause of noise occurrence will be described. The noise is caused by horizontal MOS FET
30 switch which opens or closes a circuit. It is most serious problem, which causes in the case that a wiring capacitance on vertical lines V_1 to V_n is large and electrode-substrate capacitance of transistors formed on V_1 to V_n is large, so that noise charge which remains on the lines is read out. There is no comparison between the amount of noise and the capacitance of

the receptive portion, so that the S/N ratio is considerably decreased. In addition to the above mentioned problem of noise, there is one more problem of smear for both CCD type and MOS type. One of reasons is due to occurrence charge caused by light, which is incident upon the other portion in addition to the receptive portion, is signal lines.

Therefore, elements in thin film form is formed by utilizing an insulator as a substrate, so that wiring capacitance is considerably reduced. Further, S/N ratio is increased by forming additional capacitor on the receptive element. For example, as the additional capacitor, a thin film such as SiO_2 or Y_2O_3 is deposited in addition.

"Problem To Be Solved by The Invention"

However, in the above mentioned prior art, an additional thin film has to be formed in order to connect a receptive element with an additional capacitor. Therefore, process steps will increase to cause cost up. As a result, noise will be caused because a thin film will not be formed uniformly.

Therefore, the present invention will solve the problem. An object of the present invention is to provide a solid state image pickup device having an additional capacitor with high evenness in parallel with the receptive element without increasing the process steps.

"Means To Solve The Problem"

The solid state image pickup device in the present invention is characterized in that the additional capacitor with high evenness can be easily formed in parallel with the receptive element by a method wherein a part of lower electrode of receptive element is oxidized by utilizing receptive element portion as a mask to provide a capacitor between upper and lower electrodes.

In particular, the present invention is utilized an oxidation film formed by a method wherein receptive element is performed photoetching by the technique of dry etching using Freon gas comprising oxygen. Moreover, the present invention utilizes an amorphous silicon for the portion of receptive element and a polycrystalline silicon for the drive portion, respectively. Through these procedures, the solid state image pickup device having small amount of smear can be formed increasing sensitivity and saturated light quantity.

"Performance"

According to the above mentioned structure in the present invention, an oxidation film formed on lower electrode of a receptive element will be

an additional capacitor between lower electrode and upper electrode. As a result, the solid state image pickup element having small noise will be formed increasing saturated light quantity and S/N ratio.

"Example"

5 Fig. 1 shows a configuration drawing in accordance with the present example of the present invention. Any receptive element or switching element can be used for a semiconductor substrate. In the present invention, an amorphous silicon photodiode is used as a receptive element, and poly-silicon TFT is used as a switching element, respectively. Fig. 2
10 shows an equivalent circuit of Fig. 1. In Fig. 1, (a) shows a cross sectional view and (b) shows a plan view. Process steps will be described as follows. A non-doped polycrystalline silicon layer 102 is formed on an insulating substrate 101 such as quartz glass and after forming a gate insulating film by thermal oxidation, a second polycrystalline silicon 103 to be a gate
15 electrode is formed to be also a gate line. Subsequently, ion is implanted to provide a source and drain electrode. Then, after forming SiO_2 or the like as an interlayer insulating film 104, a contact hole is formed and a vertical line 105 is formed with a conductive material such as Al, upon which a polyimide resin or the like 106 is formed for leveling as an interlayer
20 insulating film. Usually, poly-silicon TFTs are formed by the above mentioned method. Significant process steps according to the present invention will be described as follows. After forming a contact hole on the interlayer insulating film, a conductive thin film 107 is formed by using such as Cr or Al as lower electrode of pixel. This conductive thin film 107
25 should be easily oxidized and the oxide film should be high resistivity and dense since it is oxidized after the formation of the receptive film 108 using the receptive film(a photo resist may be disposed thereon) as a mask in order to form an additional capacitor. As an oxidation method, it can be considered various kinds of method, however, in case that a receptive film
30 108 is etched by plasma using oxygen and Freon, an oxidation film 109 is formed as a necessary result, so that there is no need to add oxidation process. After oxidation by the method, oxide plasma treatment may be further conducted, or oxidation with thermal nitric acid or steam oxidation may be conducted. Table 1 shows a characteristic example of forming a
35 lower electrode 107 by using oxidation of Cr and Al-Si and in accordance with the present example. Here, the receptive film thin 108 is an amorphous silicon (referred to a-Si, hereinafter) formed by GD plasma CVD,

and 110 may be any transparent conductive electrode (upper electrode), here, ITO.

Table 1

| CONDITION | ELEMENT CAPACITY (pF/100 μ m ²) | INSULATION PROPERTY |
|---|---|------------------------|
| (1) a-Si is etched by using CF ₄ +O ₂ | 0.2 | good |
| (2) O ₂ plasma treatment in addition to (1) | 0.5 | best |
| (3) thermal nitrate treatment in addition to (1) | 0.5 | good |
| (4) using Al-Si as electrode with condition (2) | 0.2 | regular |
| (5) oxidation by steam using Al-Si as electrode | 0.3 | good |

Note) An electrode used in conditions (1) to (3) is Cr.

5 In the table 1, an amount of the element capacity is calculated by adding capacitance of a-Si to additional capacitor of an oxidation film. The capacitance of a-Si is approximately 0.01pF/100 μ m². Regarding to the uniformity, the condition (3) is best of all. Under the condition (3), dispersion of all elements is within a range of $\pm 1\%$, and under the other
10 conditions, it is within a range of $\pm 2.5\%$. In any way, it is easier than the case of forming SiO₂ or dielectric thin film in additional process and probability of dispersion is small. (in case of SiO₂, the dispersion is within a range of $\pm 5\%$)

Referring to the equivalent circuit in Fig. 2, through the above
15 mentioned process, the circuit is provided with an additional capacitor Ca in parallel with the receptive element Dil.

Moreover, metal is used as a lower electrode in the above mentioned example. Instead of using the metal, by using low resistance amorphous silicon which is doped impurities, an oxidation may be performed to form
20 SiO₂ in order to use the SiO₂ as an additional capacitor.

"The effect of the Invention"

As mentioned above, according to the present invention, since the additional capacitor having a high uniformity can be formed extremely

easily and inexpensively without increasing the process steps by using the pattern of a thin film receptive element as a mask, it is possible to easily obtain excellent solid image pickup devices with low cost having a large S/N ratio and a large saturated light quantity.

5 4. Brief Explanation of The Drawings

Fig. 1 is example of a solid state image pickup device in the present invention wherein (a) is a cross sectional view and (b) is a plan view.

Fig. 2 is a equivalent circuit drawing of the example.

Fig. 3 is a usual circuit drawing of MOS type solid state image pickup
10 device.

101---substrate

103---gate electrode

105---vertical line

107---lower electrode

15 108---receptive thin film

109---oxidation film

110---upper electrode

Applicant Suwa seiko-sha

Attorney Tsutomu Mogami

⑯ 日本国特許庁 (J P)

⑭ 特許出願公開

⑬ 公開特許公報 (A)

昭61-141174

⑪ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑫ 公開 昭和61年(1986)6月25日

H 01 L 27/14
H 04 N 5/335

7525-SF
8420-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

① 発明の名称 固体撮像装置

② 特 願 昭59-263366

③ 出 願 昭59(1984)12月13日

④ 発 明 者 竹 下 哲 義 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内
⑤ 発 明 者 栗 原 一 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内
⑥ 発 明 者 岡 秀 明 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内
⑦ 発 明 者 長 谷 川 和 正 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内
⑧ 出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
会社
⑨ 代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

1 発明の名称

固体撮像装置

2 特許請求の範囲

(1) 絶縁性基板上に形成した受光素子の背面に電圧を印加する構造の固体撮像装置において該受光素子の下部電極の一部を酸化することによって上部電極との間に該受光素子と並列に容量を設けたことを特徴とする固体撮像装置。

(2) 受光素子として非晶質シリコン、そして下部電極にクロムもしくはアルミニウムを用いた受光素子で、非晶質シリコンのフォトリソグラフィと同時に酸化膜の付加容量成分を形成することを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の固体撮像装置。

3 発明の詳細な説明

(従来の技術)

本発明は、固体撮像素子を用いた固体撮像装置に関するものである。

(従来の技術)

従来、固体撮像素子としてCCD型やMOS型が採用化されている。固体撮像素子は増幅管に比べて駆動や書き込みが、消費電力が少なく、長寿命であるなどの特徴がある。さらに、CCD型とMOS型を比べると、MOS型はCCD型よりも開口率が大きくて、駆動電圧の制限がないので大きな信号量が取り出せる。しかし、MOS型は増幅が大きいという欠点がある。図3図4に代表的なMOS型の回路模式図をのせる、この図を用いて増幅の発生原因をのべると、最大の問題は水平MOSFETでスイッチの期間にともなう漏れであり、これは垂直ライン $V_1 \sim V_n$ の配線容量が大きく、さらに $V_1 \sim V_n$ についているトランジスタの電圧-容量容量が大きいためラインに現れている増幅電圧を読み出してしまふことによる。これらは、受光部の容量に比べてばたきにくいので、 $3/N$ 以上の大きな値でつながる。以上の

雑音の増大に悩まなければならぬ問題とスミアがある。これはこの3層にもVCO型にも現われその原因の一つは受光部以外に入射した光による寄生電荷が信号ラインに流入することによる。

そこで、本発明は絶縁物を用いて素子を保護化することによって配線容量を大きく低減させ、さらに受光素子に付加容量を収めてS/N比を上げる方法が考えられる。たとえば、付加容量としてSiO₂やSi₃N₄などの薄膜を新たに設ける方法がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし前述の従来技術では受光素子に付加容量を確保するのに新たに薄膜を収めてやらねばならないために製造工程が増えてしまいコストが増加するとともに、薄膜が一様に形成されにくいために雑音に結びつくことになる。

そこで本発明はこのような問題点を解決するため、その目的とするところは、製造工程を増やすことなく均一な付加容量を受光素子に並列に設けた固体撮像装置を提供するところにある。

る。受光素子及びスイッチング素子は半導体薄膜ならばいかなるものでも利用は可能であるが、ここでは受光素子として非晶質シリコンのフォトダイオード、スイッチング素子として多結晶シリコンを好んで用いて代用される。第2図は第1図の第2図面図である。第2図面図において(a)は断面図、(b)は平面図であり、製造工程としては以下に示す様になる。石英ガラスなどの絶縁基板101上にノンドープの多結晶シリコン層102を形成、熱酸化法でゲート絶縁層を形成後にゲート電極となる第2の多結晶シリコン層103を形成する。これはまたゲート・ラインともなる。その後イオン打込み等によりソースとドレイン電極を設ける。次に第1図の絶縁層104としてSiO₂などを形成した後、コンタクトホールを形成し垂直ライン105をAZなどの導電性物質で形成し、その上に第1図の絶縁層を用いて平坦化のためにポリイミド樹脂層を106として形成する。以上は一般的な多結晶ポリシリコン素子の形成方法であり、これから得られる発明に關して重要な製造工程である。第1図の絶縁層にコン

(問題点を解決するための手段)

本発明の固体撮像装置は、受光素子部分をマスクとして受光素子の下部電極の一部を酸化することによって形成される酸化層が上部電極との間で付加容量とすることで、容易に均一な付加容量が受光素子と並列に設けることができることを特徴とする。

特に受光素子のフォトエッチングに酸素含有のフロンガスを用いたドライエッチング技術を用いることで必然的にできる酸化層を利用する。また、受光素子部分に非晶質シリコンを用い、ドレイブ部分に多結晶シリコンを用いることでスミアの少ない高感度かつ飽和光量の大きい固体撮像素子となる。

(作用)

本発明の上記の構成によれば、受光素子の下部電極に形成される酸化層が下部電極と上部電極の間で素子の付加容量となり、飽和光量を増やすとともに高S/N比の低雑音固体撮像素子となる。

(実施例)

第3図は、本発明の実施例における断面図であ

トホールを形成した後、画素の下部電極としてCrやAZなどで導電性薄膜107を形成するが、ここでこの薄膜は108の受光層を形成後にこの受光層(ホトレジストがついている場合もある)をマスクとして107の導電性薄膜を酸化して付加容量部109とするため、酸化が容易で酸化層が高抵抗で緻密でなくてはならない。酸化方法としては従来の方法が考えられるが、108の受光層を酸素とフロンとのプラズマでエッチングする場合に必然的に酸化層109が形成され、なんら酸化工程を増やす必要はない。この方法で酸化した後にはさらに酸素プラズマ処理したり、熱処理などで酸化してもよく、水蒸気酸化などもよい。本実施例でこれらの酸化方法でCrとAZ-Siを下部電極107とした場合の特性例を第4図に示す。ここで、108の受光層は0.3μmプラズマCVD法で形成した非晶質シリコン(以下、a-Siと略す)、109は導電性層(上部電極)ならばいかなるものでもよいが、ここではITOを用いている。

| 条 件 | 電子容量($\times 10^2/100\mu\text{m}^2$) | 絶縁性 |
|--|--|-----|
| (1) $\text{CP}_2 + \text{O}_2$ で $\alpha\text{-Si}$ を エッチング | 0.2 | 良 |
| (2) (1)に加えて O_2 プラズマ 処理 | 0.5 | 最良 |
| (3) (1)に加えて 熱酸化処理 | 0.5 | 良 |
| (4) 電極に AL-Si を用い (2)の条件 | 0.2 | 良 |
| (5) 電極に AL-Si を 用いて水素気で酸化 | 0.3 | 良 |

注) (1)～(3)の下部電極は Cr である。

表 1 表

表 1 表で電子容量は $\alpha\text{-Si}$ の容量と酸化膜の付加容量との和であるが、 $\alpha\text{-Si}$ の容量は $0.01 \text{ pF}/100 \mu\text{m}^2$ 程度である。均一性に潤しては、(3)の条件がもっとも良く全電子でのバラツキは ± 1 以内であり、他は ± 2.5 以内である。いずれに

(a) は断面図で、(b) は平面図である。

第 2 図は実施例の回路図である。

第 3 図は一般的な MOS 型固体撮像装置の回路図である。

- 101 基板
- 103 ゲート電極
- 105 垂直ライン
- 107 下部電極
- 108 受光障壁
- 109 酸化膜
- 110 上部電極

以 上

出 願 人 株式会社 防衛工業

代 理 人 特 許 士 最 上



てもこれらは SiO_2 や誘電率等を別途に形成するよりもむしろ著しく容易であり、バラツキも少ない (SiO_2 の場合は ± 5 も程度)。

第 2 図の回路図であると、以下の工程により受光電子 D に付加容量 C_D が並列についた回路となる。

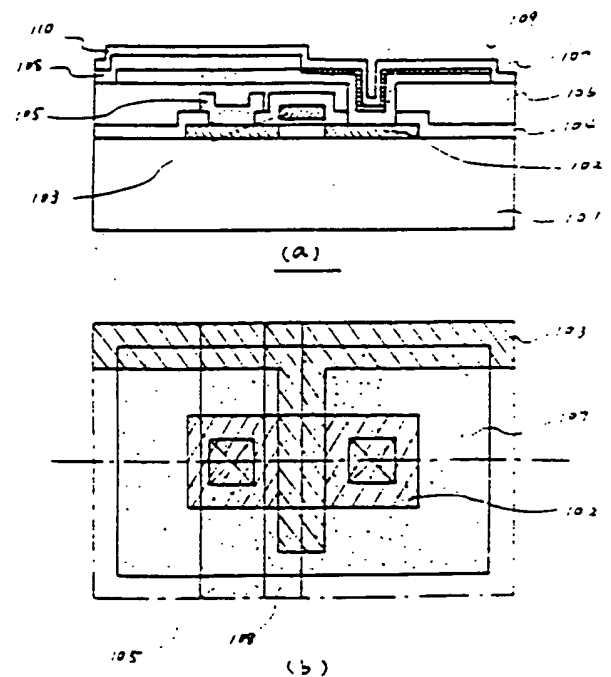
また上記例では下部電極として金属をあげたが不純物ドーピングされた低抵抗非晶質シリコンを用いて、酸化を行ない SiO_2 を形成して付加容量として用いることもできる。

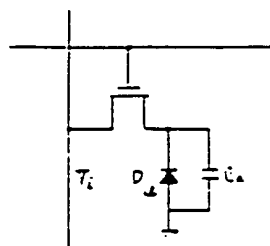
(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、導電受光電子のパターンをマスクとすることで製造工程を簡易なことなく、著しく容易に均一性の高い付加容量を形成できるために S/N 比が大きく、飽和電流の大きいすぐれた固体撮像装置を低コストで容易に造ることができる。

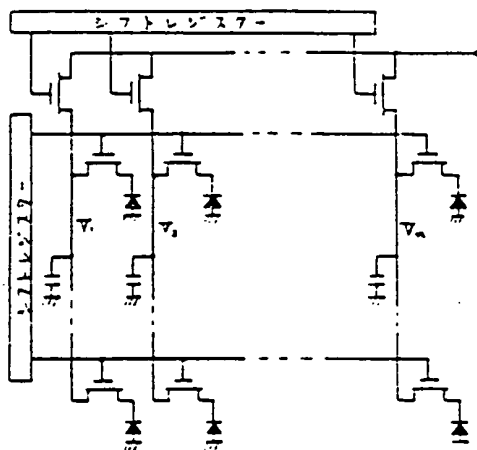
4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の固体撮像装置の実施例であり





第 2 図



第 3 図